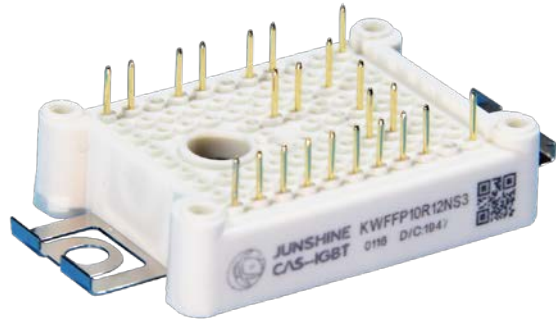




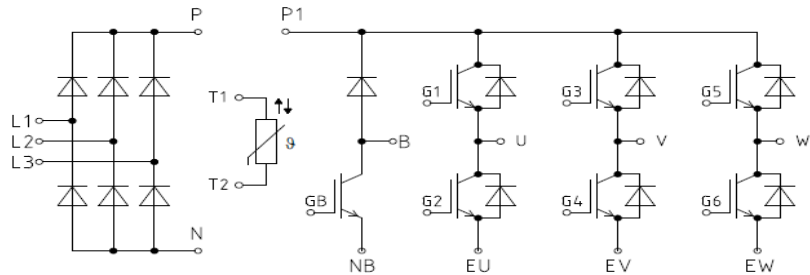
特征

- 采用最新沟槽栅场截止型IGBT芯片
- 集成NTC温度传感器
- 高可靠性及热稳定性，良好的参数一致性
- 100% RBSOA测试 ($2 \times I_C$)
- 低通态损耗 ($V_{CE}=1.85V$)
- 低关断损耗 ($E_{off}=0.5mJ$)
- 高短路耐量 ($>10\mu s$)



应用领域

变频 电机驱动控制 等



IGBT(逆变器 and 制动-斩波器)最大额定值 (未特殊说明时, $T_j=25^\circ C$)

	参数	符号	条件	额定值	单位
IGBT, 逆变器 & 制动-斩波器	集电极-发射极耐压	V_{CES}		1200	V
	栅极-发射极耐压	V_{GES}		± 20	
	集电极电流	I_C	$T_C=25^\circ C$ $T_C=100^\circ C$	20 10	A
	集电极重复峰值电流	I_{CRM}	$t_p=1ms$	20	
	总功率损耗	P_{tot}	$T_C=25^\circ C, T_{vjmax}=150^\circ C$	105	W
	短路承受时间	t_{SC}	$V_{GE}=15V, V_{CC}=600V,$ $T_j=150^\circ C$	>10	μs
	工作结温	T_{vjop}		$-40 \sim 150$	$^\circ C$

IGBT(逆变器和制动-斩波器)电学特性 (未特殊说明时, $T_j=25^\circ\text{C}$)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
静态特性						
集电极-发射极击穿电压	$V_{(BR)CES}$	$V_{GE}=0V, I_C=0.5mA$	1200	-	-	V
导通压降	$V_{CE(sat)}$	$V_{GE}=15V, I_C=10A$ $T_j=25^\circ\text{C}$ $T_j=150^\circ\text{C}$	- -	1.85 2.20	- -	
阈值电压	$V_{GE(th)}$	$I_C=0.5mA, V_{CE}=V_{GE}$	-	5.90	6.70	
集电极-发射极漏电流	I_{CES}	$V_{CE}=1200V, V_{GE}=0V$	-	-	1.50	mA
栅极-发射极漏电流	I_{GES}	$V_{CE}=0V, V_{GE}=20V$	-	-	300	nA
动态特性						
输入电容	C_{iss}	$V_{CE}=25V$	-	860	-	pF
输出电容	C_{oss}	$V_{GE}=0V$	-	53	-	
反馈电容	C_{rss}	$f=1MHz$	-	16	-	
栅电荷	Q_G	$V_{CC}=200V, I_C=10A, V_{GE}=15V$	-	59	-	nC
集电极短路电流	I_{SC}	$V_{GE}=15V, V_{CC}=600V,$ $T_j=150^\circ\text{C}$	-	40	-	A
开关特性 (感性负载)						
开通延迟时间	$t_{d(on)}$	$T_j=25^\circ\text{C}$ $V_{CC}=600V$ $I_C=10A$ $V_{GE}=\pm 15V$ $R_G=47\Omega$	-	35	-	ns
上升时间	t_r		-	50	-	
关断延迟时间	$t_{d(off)}$		-	167	-	
下降时间	t_f		-	159	-	
开通损耗	E_{on}	$T_j=150^\circ\text{C}$ $V_{CC}=600V$ $I_C=10A$ $V_{GE}=\pm 15V$ $R_G=47\Omega$	-	0.56	-	mJ
关断损耗	E_{off}		-	0.50	-	
开关损耗	E_{ts}		-	1.06	-	
开通延迟时间	$t_{d(on)}$	$T_j=150^\circ\text{C}$ $V_{CC}=600V$ $I_C=10A$ $V_{GE}=\pm 15V$ $R_G=47\Omega$	-	28	-	ns
上升时间	t_r		-	50	-	
关断延迟时间	$t_{d(off)}$		-	225	-	
下降时间	t_f		-	205	-	
开通损耗	E_{on}	$T_j=150^\circ\text{C}$ $V_{CC}=600V$ $I_C=10A$ $V_{GE}=\pm 15V$ $R_G=47\Omega$	-	0.56	-	mJ
关断损耗	E_{off}		-	0.67	-	
开关损耗	E_{ts}		-	1.23	-	

二极管(逆变器和制动-斩波器)最大额定值 (未特殊说明时, $T_j=25^\circ\text{C}$)

参数	符号	条件	额定值	单位
反向重复峰值电压	V_{RRM}		1200	V
连续正向直流电流	I_F	$T_C=25^\circ\text{C}$	30	A
		$T_C=100^\circ\text{C}$	15	
正向重复峰值电流	I_{FRM}	$t_p=1\text{ms}$	30	
工作结温	T_{vjop}		-40~150	$^\circ\text{C}$

二极管(逆变器和制动-斩波器)电学特性 (未特殊说明时, $T_j=25^\circ\text{C}$)

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
静态特性						
正向压降	V_F	$V_{GE}=0\text{V}, I_F=15\text{A}$	-	1.85	-	V
		$T_j=150^\circ\text{C}$	-	1.75	-	
开关特性						
反向恢复时间	t_{rr}	$T_j=25^\circ\text{C}$	-	130	-	ns
反向恢复电荷	Q_{rr}	$V_R=600\text{V}, I_F=15\text{A}$	-	1.07	-	μC
反向恢复峰值电流	I_{rrm}	$-di/dt=600\text{A}/\mu\text{s}$	-	18.0	-	A
反向恢复时间	t_{rr}	$T_j=150^\circ\text{C}$	-	210	-	ns
反向恢复电荷	Q_{rr}	$V_R=600\text{V}, I_F=15\text{A}$	-	2.15	-	μC
反向恢复峰值电流	I_{rrm}	$-di/dt=600\text{A}/\mu\text{s}$	-	22.0	-	A
壳到结的热阻	R_{thjcd}	每个二极管	-	1.6	-	K/W

二极管(整流器)最大额定值 (未特殊说明时, $T_j=25^\circ\text{C}$)

参数	符号	条件	额定值	单位
反向重复峰值电压	V_{RRM}		1600	V
正向平均电流	$I_{F(AV)}$	$T_C=100^\circ\text{C}$	10	A
正向浪涌电流	I_{FSM}	$t_p=10\text{ms}, T_j=25^\circ\text{C}$	120	
电流时间积分	$I^2 t$	$t_p=10\text{ms}, T_j=25^\circ\text{C}$	72	A^2s
工作结温	T_{vjop}		-40~150	$^\circ\text{C}$

二极管(整流器)电学特性 (未特殊说明时, $T_j=25^\circ\text{C}$)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
静态特性						
反向重复峰值电压	V_{RRM}	$I_R=0.1\text{mA}$	1600	-	-	V
正向压降	V_F	$V_{GE}=0\text{V}, I_F=10\text{A}$ $T_j=25^\circ\text{C}$ $T_j=150^\circ\text{C}$	- -	1.05 1.0	- -	V
反向漏电流	I_R		-	-	1	mA

模块

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
绝缘测试电压	V_{ISOL}	$f = 50\text{Hz}, 1\text{minute}$	2500	-	-	V
最大结温	$T_{vj\max}$		-	-	150	$^\circ\text{C}$
工作结温	T_j		-40	-	150	$^\circ\text{C}$
外壳—散热器热阻	$R_{\theta CS}$	每个模块	-	0.10	-	K/W
储存温度	T_{stg}		-40	-	125	$^\circ\text{C}$
模块安装扭距	M	Mounting Screw:M4	1.30	-	1.70	N·m
重量	G		-	24	-	g

模块热学特性

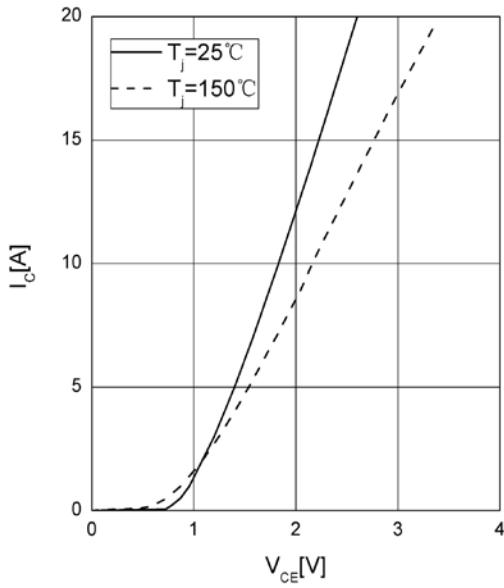
参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
壳到结的热阻	R_{thJC}	每个IGBT	-	1.20	-	K/W
壳到结的热阻	R_{thJCD}	每个二极管	-	1.60	-	
壳到散热片的热阻	R_{thCH}	整个模块	-	1.15	-	

负温度系数热敏电阻

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
额定电阻值	R_{25}	$T_C=25^\circ\text{C}$	-	5	-	K Ω
R100偏差	$\Delta R/R$	$T_C=25^\circ\text{C}, R_{100}=481\Omega$	tbd	-	tbd	%
耗散功率	P_{25}	$T_C=25^\circ\text{C}$	-	tbd	-	mW
B-值	$B_{25/50}$	$R_2=R_{25}\exp[B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298.15\text{K}))]$	-	3380	-	K
B-值	$B_{25/80}$	$R_2=R_{25}\exp[B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298.15\text{K}))]$	-	3440	-	K

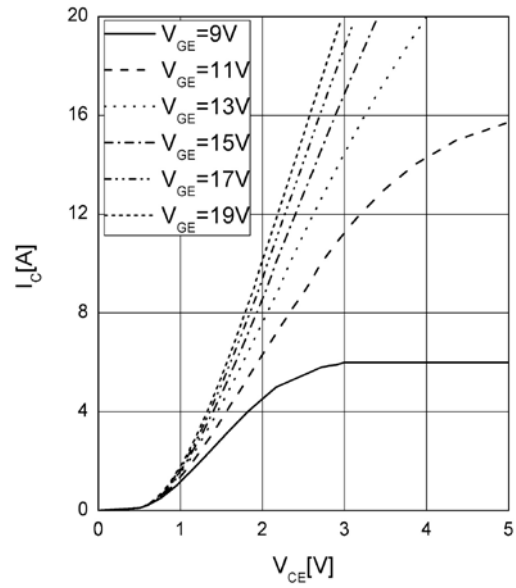
输出特性 IGBT, 逆变器&斩波-制动器 (典型)
output characteristic IGBT,
Inverter&Brake-Chopper (typical)

$I_C = f(V_{CE}), V_{GE} = 15\text{ V}$



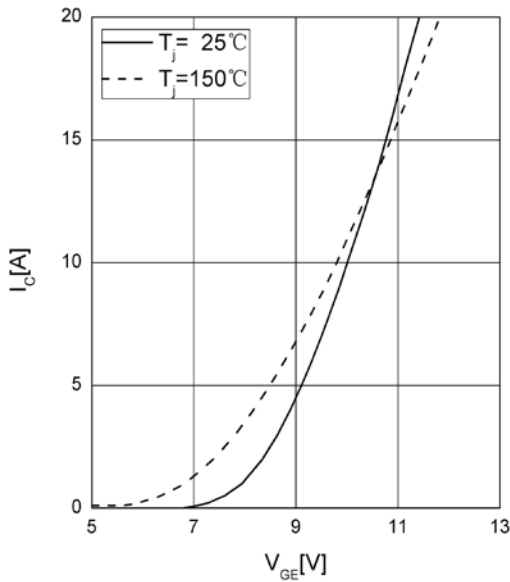
输出特性 IGBT, 逆变器&斩波-制动器 (典型)
output characteristic IGBT,
Inverter&Brake-Chopper (typical)

$I_C = f(V_{CE}), T_j = 150^\circ\text{C}$



传输特性 IGBT, 逆变器&斩波-制动器 (典型)
transfer characteristic IGBT,
Inverter&Brake-Chopper (typical)

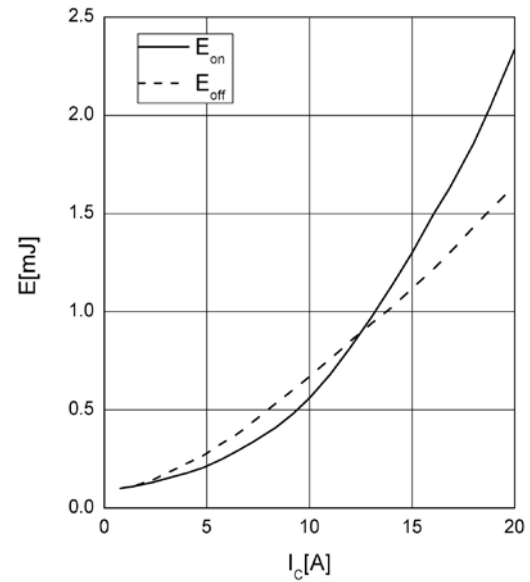
$I_C = f(V_{GE}), V_{CE} = 20\text{ V}$



开关损耗 IGBT, 逆变器&斩波-制动器 (典型)
switching losses IGBT,
Inverter&Brake-Chopper (typical)

$E_{on} = f(I_C), E_{off} = f(I_C)$

$V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_G = 47\ \Omega, V_{CE} = 600\text{ V}, T_j = 150^\circ\text{C}$



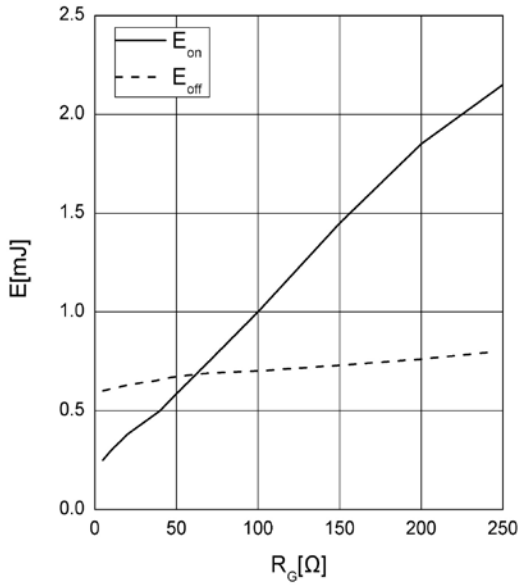
开关损耗 IGBT, 逆变器&斩波-制动器 (典型)

switching losses IGBT,

Inverter&Brake-Chopper (typical)

$E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$

$V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $I_C = 10\text{ A}$, $V_{CE} = 600\text{ V}$, $T_j = 150^\circ\text{C}$



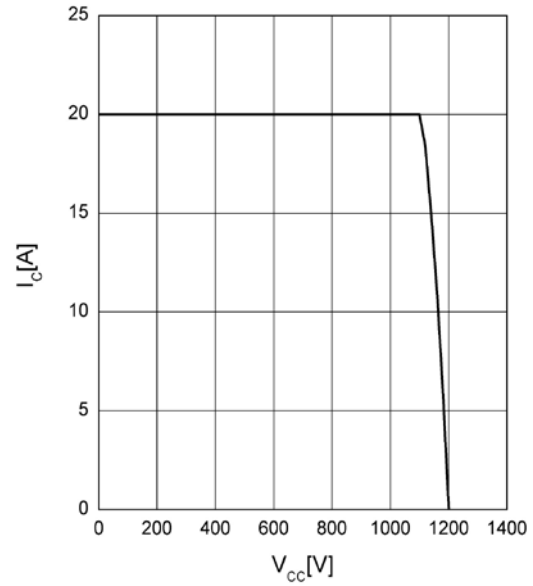
反偏安全工作区 IGBT, 逆变器&斩波-制动器 (RBSOA)

reverse bias safe operating area IGBT,

Inverter&Brake-Chopper (typical)

$I_C = f(V_{CE})$

$V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Goff} = 47\ \Omega$, $T_j = 150^\circ\text{C}$

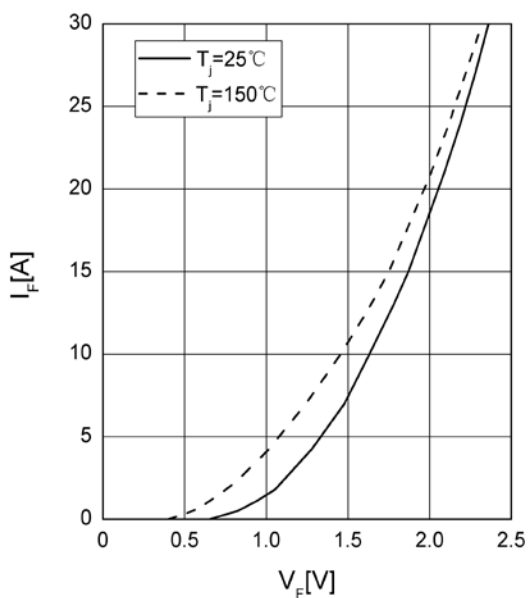


正向偏压特性 二极管, 逆变器&斩波-制动器 (典型)

forward characteristic of Diode,

Inverter&Brake-Chopper (typical)

$I_F = f(V_F)$

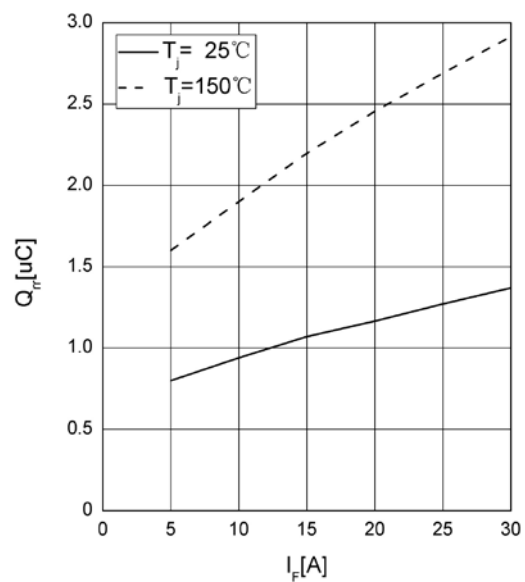


恢复电荷 二极管, 逆变器&斩波-制动器 (典型)

recovered charge of Diode,

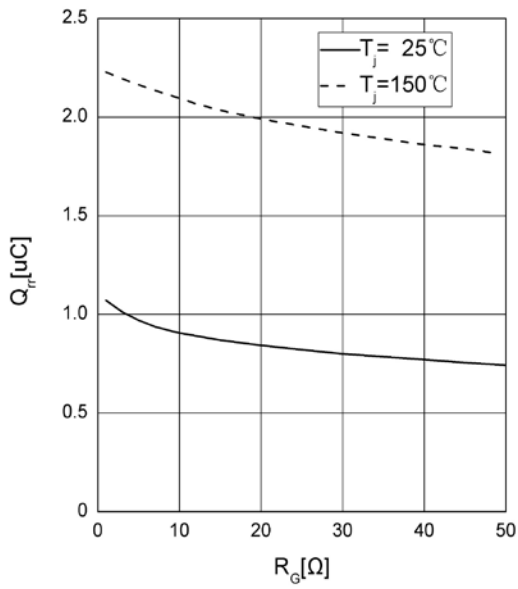
Inverter&Brake-Chopper (typical)

$Q_{RR} = f(I_F)$



恢复电荷 二极管,逆变器&斩波-制动器 (典型)
 recovered charge of Diode,
 Inverter&Brake-Chopper (typical)

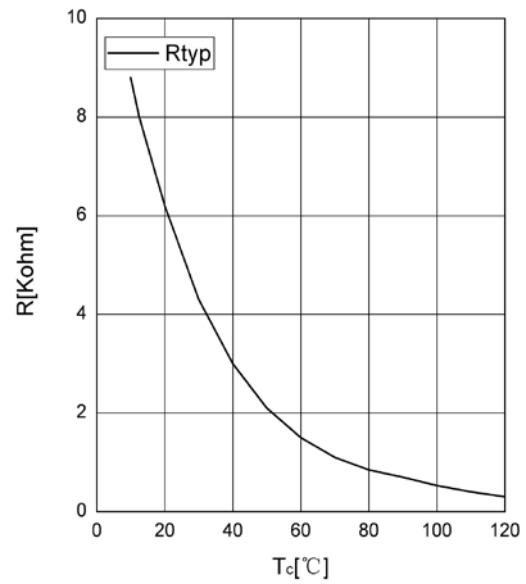
$Q_{rr} = f(R_G)$, $I_F=15A$, $V_{CE} = 600V$



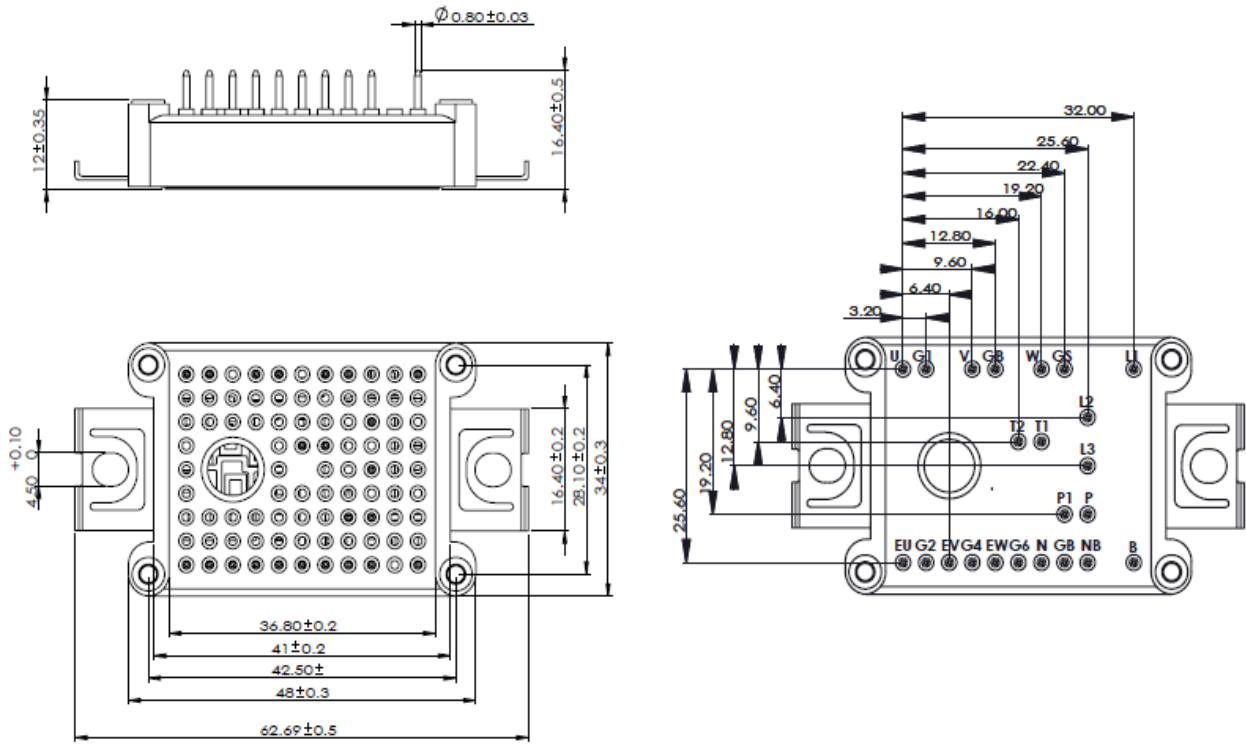
负温度系数热敏电阻 温度特性

NTC temperature characteristic (typical)

$R = f(T)$



模块尺寸 (单位: mm)



电路示意图

